

3SK115

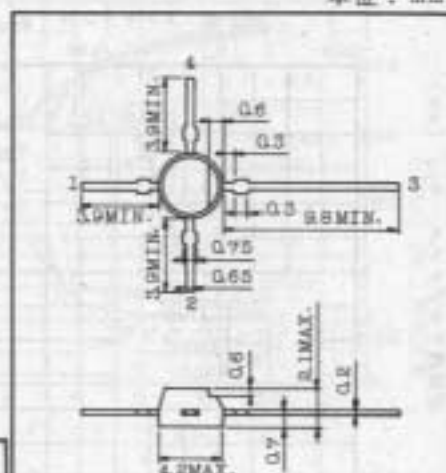
シリコン NチャンネルデュアルゲートMOS形

- TVチューナ、UHF 高周波増幅用
- TVチューナ、UHF ミキサ用

単位：mm

特長

- ・ 混交調特性が非常に優れています。
- ・ 帰還容量が小さい。 : $C_{res} = 0.02\text{pF}$ (標準)
- ・ 低雑音です。 : $NP = 3.2\text{dB}$ (標準)



- 1 ゲート 1
- 2 ソース
- 3 ドレイン
- 4 ゲート 2

最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	定 格	単 位	JED8C	EIAJ	東 芝
ドレイン・ソース間電圧	V_{DS}	16	V	-	-	-
ゲート 1・ソース間電圧	V_{G1S}	± 8	V	-	-	-
ゲート 2・ソース間電圧	V_{G2S}	± 8	V	-	-	-
ドレイン電流	I_D	30	mA	-	-	-
許 容 損 失	P_D	200	mW	-	-	-
チ ャ ネ ル 温 度	T_{ch}	125	°C	-	-	-
保 存 温 度	T_{stg}	-55~125	°C	-	-	-
				JEDEC	-	-
				EIAJ	-	-
				東 芝	-	2-4P1A

電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
ゲート 1 漏れ電流	I_{G1SS}	$V_{DS}=0, V_{G1S}=\pm 6V, V_{G2S}=0$	-	-	± 50	nA
ゲート 2 漏れ電流	I_{G2SS}	$V_{DS}=0, V_{G1S}=0, V_{G2S}=\pm 6V$	-	-	± 50	nA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSX}$	$V_{G1S}=-4V, V_{G2S}=-4V, I_D=100\mu A$	15	-	-	V
ドレイン電流 (I_{DSS})	I_{DSS} (註)	$V_{DS}=6V, V_{G1S}=0, V_{G2S}=3V$	0	-	6	mA
ゲート 1・ソース間しき断電圧	$V_{G1S(OFF)}$	$V_{DS}=6V, V_{G2S}=3V, I_D=100\mu A$	-15	-	1	V
ゲート 2・ソース間しき断電圧	$V_{G2S(OFF)}$	$V_{DS}=6V, V_{G1S}=3V, I_D=100\mu A$	-10	-	1	V
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS}=6V, V_{G2S}=3V$ $I_D=10mA, f=1kHz$	-	17	-	mS
入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS}=6V, V_{G2S}=3V$ $I_D=10mA, f=1MHz$	-	2.0	-	pF
帰 還 容 量	C_{res}		-	0.02	-	pF
電 力 利 得	G_{ps}	$V_{DS}=6V, V_{G2S}=3V$ $I_D=10mA, f=800MHz$ (註1)	-	16	-	dB
雑 音 指 数	NP		-	3.2	-	dB

注: I_{DSS} 区分 0: 0~2mA, Y: 1~6mA

